GEMaC

Groupe d'Étude
de la Matière Condensée

TRAITEMENTS PRÉ ET POST-CROISSANCE

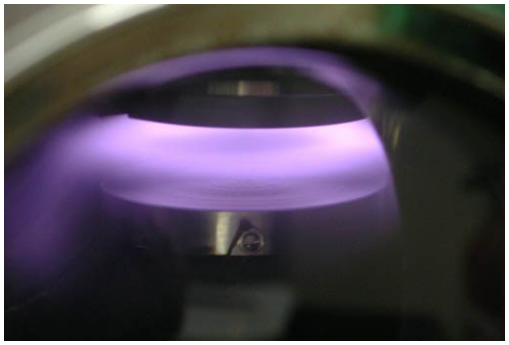
Four de recuit haute température

Modèle : Elite Thermal Systems TSH16/50/180
Recuit jusqu'à 1600°C sous flux d'azote dédié au diamant semiconducteur.



Hydrogénation / Deutération par plasma capacitif RF 13.56 MHz

Pour semiconducteurs III-V, II-VI
Modèle : réacteur MECA2000
Conditions : 1 Torr, 25 - 500°C
Echantillon soit dans le plasma, soit en aval du plasma (remote)



Hydrogénation / Deutération par plasma micro-ondes 1.45 GHz

Pour le diamant
Modèle : réacteur Materia utilisé pour la croissance diamant
Conditions : 10-20 Torr, 450 - 1000°C

